⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-267734

| @Int_Cl_4 | | 識別記号 | 庁内整理番号 | | 43公開 | 昭和61年(| 198 | 6)11月27日 |
|-----------|-------|-------|----------------------------|------|------|--------|-----|----------|
| G 02 F | 1/133 | 1 1 8 | D - 8205-2H F - 8205-2H | | | | | |
| | | 129 | D-7348-2H B-7348-2H | | | | | |
| G 09 F | 9/35 | | 6810-5C | 審査請求 | 未請求 | 発明の数 | 1 | (全6頁) |

公発明の名称 液晶電気光学装置

到特 期 昭60-110667

砂出 顋 昭60(1985)5月23日

@発明者 曽根原 富雄

砂発明者 有賀 修二

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

⑪出 顋 人 セイコーエブソン株式

会社

20代理人 弁理士 最上 務

明 細 看

1 猪明の名称 被品置级光学磁波

2 特許請求心超出

相対する 2 枚の裏板間に強弱 電性 底晶 組成物を 探持して成る痕晶パネルに、 進界を印加し該痕品 パネルの光散乱状態を側回する痕晶 電気光学 後世 において、アクテイプマトリクス駆動手段を有す ることを特徴とする底晶 電気光学後世。

5 発明の辞機な説明

〔 産業上の利用分野〕

本発明は強終退性液晶組成物の飲息現象を利用 した液晶電気光学装置の高情報量化に関するもの である。

[発明の妖要]

本語明は強弱選性液晶組成物の光散乱状態を印 加電場により制御する底晶は気光学装置において、 アクティブマトリクス駆動手段を設慮したことに より、高情報 並の表現を可能にしたものである。 (従来の技術)

強励電性放晶の光飲乱状態を印加電場によつて 制御する電気光学効果(以下、Ferroelectric Liguid Crystal Scattering 効果, PL B 効果 と称する)は、Ferroelectrica 59, P. 145~ 160, 1984 に配送されるように、単一セルに よる製動が確認されている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、前述の従来技術ではPLB効果が明瞭なしきい値をもたないため情報提現に対して、スタテック軟動された表示エレメントを複数個組合せる他なく、高情報量の表現は不可能であつた。

本発明はこのような問題点を解決するもので、 その目的とするところは、FLE効果を高情報量 表現に応用した液晶電気光学装置を提供すること にある。

(問題点を併決するための手段)

本発明の液晶 電気光学接載は、 F L B 効果を用いる液晶パネルの 製動手段としてスイッチング集

子エレメントを各級示画器に配したアクテイブマ トリクスを有することを特徴としている。

(作用)

本発明は単一セルでの動作のみ可能な B L B 効果を、アクティブマトリクスによつて駆動を行な 9 ものである。アクティブマトリクスは各面案に対してスイッチング案子を有してかり、非常に短かい選択時間であつても、各面案に配置されたスイッチング案子によつて 1 0 0 5 に近いデューティー比での駆動が可能となる。このため B L B 効果を用いた感情報量表現可能な 底晶 電気光学装置が実現される。

(実施例)

以下、本発明について実施例に基づいて詳細に 説明する。

突鹿例1

実施例1はアクテイプマトリクス業子として TBT(海膜トランジスタ)を用いたFL8効果パネルの場合である。

軍1図は一部を取り出した斜視図である。各画

いているため、液晶層には数 m soo~数10 m soo周 期の極性反転した進圧と直流電圧を印加する必要 がある。極性反転周期は液晶の分子運動の速度、 自発分布の大きさに依存している。本実施例の乗 件は約80℃に液晶パネルの温度を保ち液晶をカ イラルスメクチック相とした状態で5088の値 性反転電界をかけた。この値性反転電界は、第2 図に示すようにフィールド(反乱パネル全面を点 展次、あるいは継順次にアドレスする時間)@. **自毎にTPTのソース配線切にトランスミツショ** ンゲート個を通じて加わるビデオ信号のを反転し て作られる。これを飲乱信号のと称し、新2図中 に斜線で示した。共通電低④はこのときビデオ信 **身の圧圧中間の単位をとつている。したがつて、** 飲乱状態に対応した画楽には、フィールド毎に低 性の反転した電位が書き込まれ、強弱運性産品に は散乱を誘起する反転電圧が加わることにたる。

とれに対し値成基圧の印刷はビデオ信号をフィールド低に反転せずに与えればよい。 第 2 図のビデオ信号の望の部分である。

果に対応して国家電電①、TPT③が設置され、 対向基板③上の共通電極④との間に強誘電性板晶 組成物③をはさんだ構成となつている。

本実施例の場合、TPT③は石英ガラス基根上のポリシリコンTPTであり、市販のアクテイブマトリクス型液晶ポケットテレビに用いられているものと同様に形成されたものである。他の構成部材についても同様である。

強勝単性液晶組成物⑤は本実施例の場合、DOBAMBOを用い、基板の配向処理として有破膜のラビング処理を施している。パネル間のギャップは2ムABである。ギャップは必要となる散乱の大きさ、動物単圧によつて通算過択される。

また同じギャップでも光路を2倍にしより強い 光飲乱を得るために、画業電低①あるいは共通電 低①を光反射性電低、例えばアルミニウムや銀の よりな金銭得線電低にすることも有効である。

次に駆動について説明する。 解 2 図は F L S 効果 T F T 成晶パネルの駆動例を示す図である。 本 実施例の場合、 B O B A M B C O F L S 効果を用

つまりビデオ信号値の発生は、2フイールド毎の信号フィールド的にかいて、投示データに従つて Ov と Vマ の間で選択され、さらに全 O N フィールド値では Vマ または O V が加わるようにして行なわれる。

さらにとれらは成晶の劣下を妨止するために、 Nフィールド毎に反転されている。 第2図中の® 及び砂がこれを示している。

和2図中にはゲート配線型側の信号を省略してあるが、これは市成のポケット液晶テレビに用いられているものと同様、順次選択されるようたパルスが印加される。これらは日経エレクトロニクス9月10日号(1984)P211を参照されたい。

また第2図のビデオ信号は説明を簡単にするためのマあるいは V v O 2 値信号を加えたが、電圧振中 o から V v の間で変調し、散乱強度の変化を与えることができる。この時のビデオ信号の例を第3図に示す。

以上述べたよりにBL8効果をTPTアクティ

プマトリクス駆動手段により多面素の契別に応用 することが可能となつた。 本実施的はTPTを採 用した例であるが、问様な 5 端子スイッチ業子で あれば応用可能である。また界面配向によるメモ リー性などが残る場合は必ずしも晦柔 延慮に直流 世圧と交流 低圧のいずれかが常に印加されている 必要はない。

夹胞例 2

契施例2はアクテイプマトリクス案子として 2 端子双方向性スイッチング案子である M I M (金以一絶歌体一金銭)ダイオード⑪を用いた場合である。

ルの2フレーム交流方式と同等である。データ線 信号(編6凶6),向)は、全0パフレーム図と信。 **ヴァレーム台を父互にとるようになつている。金** O N フレーム線では、2フレーム交流方式の O N レベルをとる。信号フレーム@では、散乱つまり 交流選圧とする場合は O N レベルの、非敗乱すな わち直流進圧とする場合はOFBレベル留をとる よりにしている。信号フレームは通常の単端マト リクス厳強パネルと同じ河え方である。とのよう にして画楽には第6図(10)。(6)に示す 進圧が印加さ れる。 鹵果(4,3), 鹵果(4,4) に加わる 進圧で画素回路での作動が異なるのは、幼の選択 期間である。面果(4,3)は匈の選択朔間に負 個に新た化書を込まれるのに対し、画景(4.4) は中の過択利間にHIHダイオードOFFしたま まであり、強縛延性疫品増は正側の延圧を保持し 鋭ける。この結果直流は圧と交流は圧の提示デー 々に従つた変調が可能となつた。本異磁例ではフ レームの反転過吸紋は実施内1と同じく508m とした。また仮晶の劣下を妨止するためにNフィ

な双方向性の非線型特性を有している。MIMダイオードの製造法、パネル構成は、特別的 5 5 ー 1 6·1 2 7 3 や Proceedings of JAPAN DISPLAY '83 P.404 に配送されるものと同等である。

次に収めについて説明する。第6図はましる効果はIM成晶パネルの駆動例を示している。(a)は 5 列目のデータ線上のデータ信号変形。(d)は何じく4 列目のデータ信号変形。(b)・(e)はそれぞれ順震(4,3)・(4,4)に加わる選圧変形を示している。また(e)は、4 行目の選査運輸信号変形である。これらの信号発生は従来の単純マトリクス型液晶投示後速と同様に行なりことができる。

ここで各借号放形について詳しく説明する。 PL8効果は実施例1でも述べたように交流 選圧 と直流 選圧の切換が必要である。 本実施例の場合、 フレーム(全國業をアドレスする時間) 100 , 200 年 に低性反転が可能とする必効とした。 走金 遺価信 号(罪6凶(8)) は通常の単純マトリクス 液晶パネ

ールド毎に第6図の信号政形をすべて反転し、反 転した直旋選圧の印加をすることもできる。

以上は簡単のために 2 値級規の場合について述べたが、階調機領も可能である。 これは、 敵乱強 匿 いべんの変調を 0 k レベルのと 0 F F レベルの 0 間で版中変調することによつて実現される。 こ の場合の型動は実施別 1 の 3 選子の場合と類似と なる。

以上述べたように2端子双方向性スイッチング ス子の一例としてMIMダイオードをBLB効果 の必動果子に採用することによつて、多画異の表 現か可能となつた。

奖施例 3

実施例3は必加マトリクス架子に複数のスイッテング架子を用いたFLB効果液晶パネルの場合である。

パネルの構成はアクテイプマトリクス基板と強 設定性液晶組成物層、対向基板であり実施例1、 実施例2と同じであるので省略する。第7図(a)に 一面米の磁能ダイヤグラム、487図(b)にトランジ スタを 2 個用いた場合の等価回路図を示す。 透択回路 2 によって 2 個別では、非地の 2 によって 2 の 2 によって 3 の 3 によって 3 の 3 にはられた 4 の 3 にはられた 6 の 3 にはられた 6 の 3 にはられた 7 の 3 にはられた 6 の 3 にはられた 7 の 3 にはられた 6 の 3 にはられた 7 の 3 にはられた 8 の 3 にはられた 8

次に簡単に動作を説明する。ソース線切とゲート配制には画業選択のためのサドレメングバルスが印加され、一画面の生成毎に1回当事画業が選択される。選択された際の表示情報は、ソース線から保持用キャパンタ図に選圧として与えられ、 保持用キャパンタは次の選択まで情報を保持して

インビーダンスを利用することによつて、簡単な 2 つのトランジスタ構成で P L B 効果に必要な交 能に直旋電圧の切換が可能となつた。

突続のマトリクス素子は、突施例1と同じく TFTや、81基板上に形成されるMOSトランジスタによつて構成される。またこれらの顕素選択の手法は、前述した液晶ポケットテレビと同等に行なつている。

さらに液晶の劣下を妨止するために、N フィールド毎に直流電圧原のの値性を反転し、N フィールド毎の交流戦動としてもよい。

(発明の効果)

以上述べたように本発明によれば、FLS効果をアクテイブマトリクスによつて数効することによつて、FLS効果の使れた特性を持つ多画素を有した高情報量対応の電気光学袋童を実現できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はFLB効果TFT被晶パネルの斜視図。 第2図はFLS効果TFT被晶パネルの幽迦図。

いる。ととまでの動作は実施例1の3端子スイツ チングアクテイプマトリクスと同じように行なわ れる。次にスイッチングトランジスを含は保持用 ・キャパショのの世圧によつてゲート電圧が制御さ れ、ON-OPPする。 スイッチングトランジス タロのソースには疫苗陣、共通電極回を通して交 飛ば圧減と道流覚圧減がつながれている。 スイツ チングトランジスタのON抵抗とOFF抵抗は根 益層の等価並列抵抗をはさんで設計され、交流電 圧成の発展周期は改晶層の並列等価時定数より短 く。またその扱力は直流は圧成の電圧よりも大き く故定されている。とのためスイッチングトラン ジスタの08-0PRに伴い、湖8図ほど示す.よ うに O N 時には返産地圧と交流 民圧のほとんどか 在品層印加電圧等となり、交流電圧の最中が直流 **ば圧より大きいため、液晶層にはFL8効果の数** 乱に十分な交流世圧がかかる。OFF時には第8 図(6)に示すよりに、交流成分の大部分はスイッチ ングトランジスタ印加電圧型となり、収益圏には

第3図は張巾変調した場合のビデオ信号図。

直旋電圧成分が印加される。このように液晶層の

第4図(a)はそLS効果NIM 版品パネルの画案 等価回路図。

第4図(b)は F L S 効果 M I M 液晶パネルの斜視図。

第5図はMIMの健康一催圧特性図。

第6図はFLB効果MIM 夜晶パネルの鉱動波形図。

据7図(a)は1画系の破能ダイアグラム図。

第1図(D)は2トランジスタによる毎価回路図。

第8図(a)、(b)は夜品階とトランジスタに印加される電圧波形図。

1 … 画景电值

2 ... T F T

4 … 共通遺極

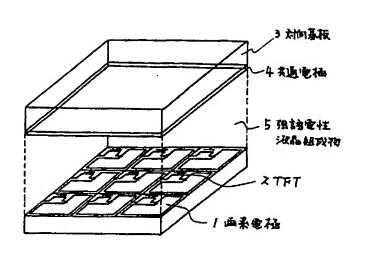
5 …強勝電性液晶組成物

1 7 ··· M I M

2 4 …通択回路

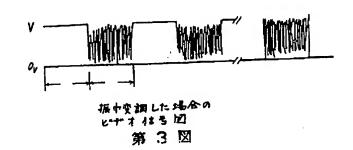
2 5 …保持回路

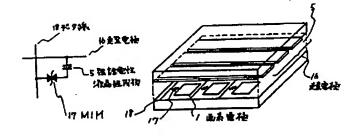
2 6 … スイッチ回路



FLS女婐 TFT液晶 パネルa 斜視図

第 1 図

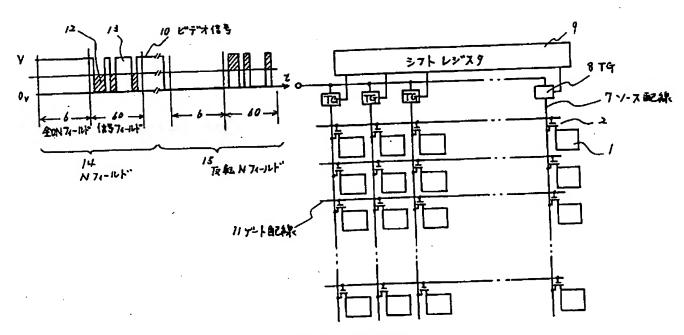




PLS如果HIM以降NAIN 中亚美年但回路回 FLS刘杲HIH浓品 小和小针视图

第 4 図(4)

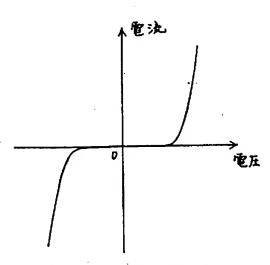
第 4 図(1)



FLS効果TFT泌品パネルa品的 図

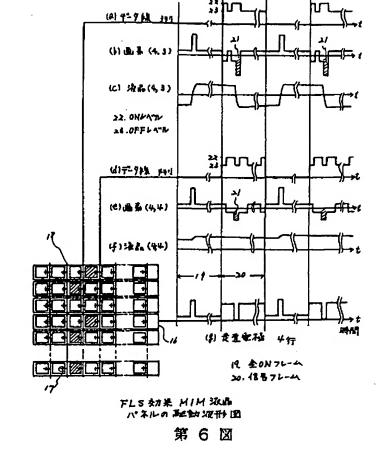
第 2 図

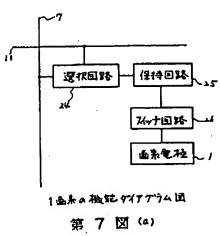
特開昭61-267734 (6)

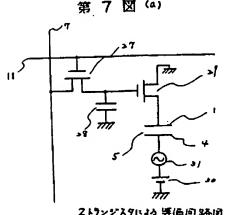


MIMa電流-電圧特性図

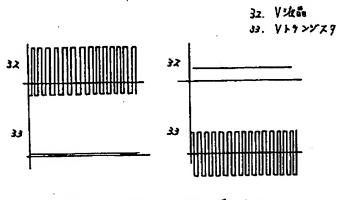
第 5 図







217ンジスタによる 等価回路回 第 7 図 (b)



液晶層とトランジスタト 炉加がれる電圧波形型 第8図(a)

液晶層とトランジスタリン 切加される電圧波形図 第8図(b)